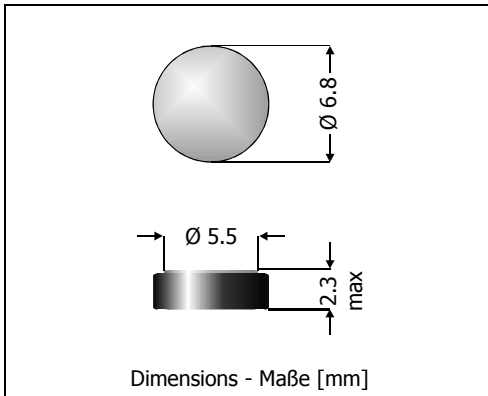


## AG12A ... AG12M

### Silicon Rectifier Cells with Polysiloxane Cover Silizium-Gleichrichterzellen mit Polysiloxan-Abdeckung

Version 2007-07-26



Nominal current 12 A

Nennstrom

Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V

Periodische Spitzensperrspannung

Weight approx. – Gewicht ca. 0.3 g

Standard packaging bulk

Standard Lieferform lose



### Maximum ratings

### Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
AG12A	50	80
AG12B	100	130
AG12D	200	250
AG12G	400	450
AG12J	600	700
AG12K	800	1000
AG12M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	12 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	$I_{FRM}$	60 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	500/550 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	1250 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-50...+150°C -50...+150°C

### Characteristics

### Kennwerte

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 12\text{ A}$	$V_F$	< 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$

1 Max. temperature of the cell  $T = 150^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Zelle  $T = 150^\circ\text{C}$